

論文 90-27-6-10

이트리아 안정화 지르코니아 소결체의 특성에 SiO₂ 및 Al₂O₃가 미치는 영향

(Effect of SiO₂ and Al₂O₃ on Characteristics of
Yttria-Stabilized Zirconia Ceramics)

孫 正 德*, 崔 時 永**, 趙 相 熙***

(Jeong Duk Sohn, Sie Young Choi, and Sang Hee Cho)

要 約

0.5 mole% SiO₂와 0~2.0 mole% Al₂O₃가 첨가된 이트리아 安定化 지르코니아 (92 mole% ZrO₂+8 mole% Y₂O₃)의 燒結性, 微細構造, 機械的 및 電氣的 性質에 대하여 조사하였다. 燒結密度는 0.5 mole% Al₂O₃ 첨가시 증가하였으나 1.0 mole% 이상 Al₂O₃가 첨가됨에 따라 감소하였다. 비커스硬度는 燒結密度에 比例하였으며, SiO₂와 Al₂O₃가 각각 0.5 mole%씩 첨가된 試片에서 가장 높은 傳導性을 나타내었다. 그리고 酸素分壓 特性에서도 SiO₂와 Al₂O₃가 각각 0.5 mole% 添加된 試片에서 가장 높은 起電力이 측정되었다.

Abstract

Sinterability, microstructure, mechanical and electrical properties of yttria stabilized zirconia (92 mole % ZrO₂ + 8 mole% Y₂O₃) doped with 0.5 mole% SiO₂ and 0~2.0 mole% Al₂O₃, were studied as a function of Al₂O₃ addition. Sintered density increased with increasing Al₂O₃ addition up to 0.5 mole% but decreased up to 1.0 mole% Al₂O₃. Vickers hardness is proportional to sintered density. The specimen added 0.5 mole% Al₂O₃ and 0.5 mole% SiO₂ exhibited a maximum conductivity. And the specimen added 0.5 mole% Al₂O₃ and 0.5 mole% SiO₂, was measured a maximum electromotive force for a characteristics of oxygen partial pressure.

I. 序 論

순수한 지르코니아 (ZrO₂)는 常溫에서 單斜晶 (mono-

clinic)이며 1150°C에서 正方晶 (tetragonal) 그리고 2400°C 이상에서는 立方晶의 3 가지 結晶構造를 갖고 있다. 특히 正方晶에서 單斜晶으로 相轉移 (phase transformation) 시 약 3~5% 정도의 體積增加에 의한 龜裂現相 때문에 热衝擊에 매우 약하여 耐熱材料 및 構造用 材料로서의 應用이 어렵다.^[1] 따라서 이수한 지르코니아에 MgO, CaO 그리고 Y₂O₃ 등과 같은 2價 혹은 3價의 金屬酸化物을 첨가하여 高溫相의 立方晶相을 常溫까지 安定化시켜 相轉移를 억제한 다음 사용하고 있는데 이를 安定化 지르코니아라 한다.

*準會員, **正會員, 慶北大學校 電子工學科
(Dept. of Elec. Eng., Kyungpook Nat'l Univ.)

***正會員, 慶北大學校 材料工學科
(Dept. of Materials Sci. Kyungpook Nat'l Univ.)
接受日字 : 1989年 8月 3日
(※ 본 연구는 1986年~1989년도 한국과학재단
목적기초 연구비의 지원으로 이루어진 것임.)

Hund 등^[2]은 안정화 지르코니아 燒結體의 缺陷構造는 주로 첨가시킨 安定化製의 첨가량에 따라 달라진다고 보고했다. 일반적으로 안정화 지르코니아는 순수한 지르코니아가 갖는 絶緣性과는 달리 結晶缺陷을 통한 높은 陰이온 傳導性을 나타내어 固體電解質의 성질을 나타낸다.^[1,3]

1957년 Kiukkola 등^[4]이 15% $\text{CaO} + \text{ZrO}_2$ 固體電解質을 이용한 갈바닉셀(Galvanic cell)을 제작하였으며, 1957년 R. C. Garvie 등^[5]은 부분 안정화 지르코니아(partially stabilized zirconia: PSZ)가 高韌性 및 高強度 材料로서 有望하다고 보고한 바 있다. 특히 이트리아 안정화 지르코니아(yttria stabilized zirconia YSZ)는 칼시아 안정화 지르코니아(calcia stabilized zirconia: CSZ)에 비해 低溫傳導性 및 溫度安定性이 優秀하여 自動車用 酸素센서의 母物質로 많이 이용되고 있다.

高純度의 二成分 安定化 지르코니아는 燒結과정에서 粒成長이 급격히 일어나므로 구조상의 繩密化가 어렵고 소성온도가 높은것이 缺點이다. 따라서 재료의 特性에 영향을 미치지 않고 조직이 치밀한 燒結體를 얻기 위하여 SiO_2 , Al_2O_3 , TiO_2 및 Fe_2O_3 등의 燒結調製(sintering aids)를 사용하고 있다. 그러나 이들은 不純物로 작용하므로 이 添加物이 粒成長과 材料의 機械的, 電氣的 性質에 미치는 영향에 대해 연구가 되어왔다.^[6,7] 1961년 Coble^[8]이 Al_2O_3 에 MgO 를 소량 첨가하여 理論密度에 도달한 Al_2O_3 燒結體를 얻은 이후부터 이 방법이 많이 이용되고 있다.

본 연구에서는 自動車用 酸素센서의 母物質로 많이 이용되고 있는 이트리아 安定化 지르코니아(92 mole% $\text{ZrO}_2 + 8$ mole% Y_2O_3)에 SiO_2 를 0.5 mole% 고정시키고^[9] 소결조제로 Al_2O_3 를 0.5~2.0 mole% 첨가하여, 첨가량이 이트리아 안정화 지르코니아 燒結體의 燒結性에 미치는 영향을 X-線 回折分析 및 電子 현미경(SEM)으로 조사하였으며, 電氣的 特性은 complex impedance 방법으로, 機械的 性質은 비커스硬度와 破壞韌性으로 조사하였다. 또한 실제 酸素센서의 응용을 위하여 酸素分壓에 따른 起電力과 热衝擊 特性을 조사하였다.

II. 實驗

1. 試片의 製造

試片의 製造는 일반적인 烫業燒結體의 製造工程을 사용하였으며 그 개략은 그림 1에 나타내었다.

本 實驗에서 사용한 原料試藥은 ZrO_2 , Y_2O_3 , SiO_2 , 및 Al_2O_3 였다. ZrO_2 는 Merck 社의 일급시약, Y_2O_3 는

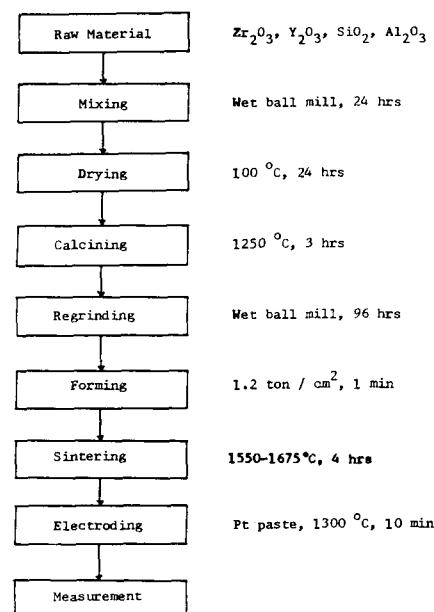


그림 1. 시편의 제조 공정도

Fig. 1. Flow diagram of fabrication process.

Aldrich 社의 G. R. 급 시약, SiO_2 는 Hayashi 社의 특급시약이며 Al_2O_3 는 和光工業社의 일급시약을 사용하였다. 표 1은 本 實驗에서 사용한 각 試片의 造成을 나타낸 것이다.

ZrO_2 92 mole%와 Y_2O_3 8 mole% 혼합한 것을 ZY8이라 하고 ZY8에 SiO_2 0.5 mole% 添加시킨 것을 ZY8S1이라 하였다. ZY8S1 조성에 Al_2O_3 양을 0.5, 1.0, 1.5 그리고 2.0 mole% 첨가시킨 試片을 각각 ZY8SA1, ZY8SA2, ZY8SA3 및 ZY8SA4라 하였다.

표 1에 나타낸 몰(mole)比에 따라 원료를 $\pm 10^{-4}\text{g}$ 의 정확도로 稱量하여 원료와 증류수 및 볼(ball)을 1:2:7의 重量比로 하여 폴리에칠렌 용기에 담아 24시간 혼합하였다. 이때 사용한 볼은 지르코니아 볼

표 1. 시편의 조성

Table 1. Composition of specimens.

Composition	Content (mole%)		Added SiO_2 mole%	Added Al_2O_3 mole%
	ZrO_2	Y_2O_3		
ZY8	92.0	8.0	0	0
ZY8S1	92.0	8.0	0.5	0
ZY8SA1	92.0	8.0	0.5	0.5
ZY8SA2	92.0	8.0	0.5	1.0
ZY8SA3	92.0	8.0	0.5	1.5
ZY8SA4	92.0	8.0	0.5	2.0

이며 혼합기의 회전속도는 120rpm이다. 혼합된 원료를 100°C의 건조로에서 충분히 건조시킨 후, 건조된 분말을 알루미나 도가니에 넣어 슈퍼칸탈 전기로에서 1250°C, 3시간 하소하였다. 하소시킨 분말을 혼합시와 같은 조건으로 96시간 재粉碎한 후 100°C에서 건조시켰다. 결합제(binder)로 PVA(5%) 수용액을 하소한 분말에 대해서 5wt% 첨가하여 잘 혼합한 후 80번 표준체를 통과시켜 과립상의 분말을 만들었다. 이 분말을 금속제의 다이스에 넣어 1.2 ton/cm²의 압력으로 成形하여 직경이 10mm, 두께가 1.5mm인 원판형 시편을 제작하였다. 이렇게 준비된 시편을 슈퍼칸탈 전기로의 공기 분위기에서 600°C, 1시간 유지시켜 PVA 水溶液을 휘발시킨 후 1550~1675°C 온도 범위에서 4시간 동안 烧結하였다. 이때 升溫速度는 200°C/hr로 하였고 下降速度는 300°C/hr로 200°C 까지 下降시켰다.

시편의 電極 形成을 위하여 烧結된 試片을 SiC 연마 400번, 600번, 800번 및 1000번 순으로 表面을 잘 研磨한 후, 알콜로 시편의 표면을 깨끗이 洗滌하고 스크린 인쇄 방법으로 Pt-paste를 시편 양쪽에 도포하여 1300°C에서 10분간 열처리하여 多空性 電極을 형성하였다.

2. 測定

本 實驗에서 試片의 特性을 調査하기 위한 測定裝備와 測定範圍는 표 2에 나타내었다.

1) 烧結 密度

燒結된 試片의 烧結密度는 Archimedes 方법으로 측정하였으며 다음 식에 의하여 구하였다.

$$\text{밀도} = \frac{\text{시편의 질량}}{\text{시편의 체적}} = \frac{m}{M-S}$$

여기서 M은 pore에 물이 함유된 試片의 무게이며 S는 pore에 물이 함유된 물속에서의 試片의 무게이고 m은 乾燥된 空氣中의 試片의 질량이다.

2) X-線 回折分析

燒結된 試片의 相의 상태를 알아보기 위하여 走査角度 20° < θ < 70° 범위에서 X-線 回折分析을 하였다.

3) 微細構造 觀察

燒結된 試片의 微細組織을 觀察하기 위하여 SiC 연마와 20000번 diamond paste로 表面을 잘 연마한 후, 1550°C에서 1시간 동안 热腐蝕(thermal etching) 시켜 주사전자 현미경(SEM)을 사용하여 粒子(grain) 및 粒界(grain boundary)를 관찰하였다.

4) ビカス硬度 및 破壊韌性

표 2. 측정 장비

Table 2. Measuring equipments.

Measurement	Measuring apparatus	Remarks
Shrinkage	Micrometer	Diameter
Density	Archimedes method	
Vickers hardness	Matsuzawa (MHT-1)	Weight:100g Time :15sec
Fracture toughness	Matsuzawa (VK-E)	Weight:10 kg Time :30 sec
Grain size	SEM (ISI-SS 130)	
Microstructure		Applied voltage:15 kv Magnification:5000
Electrical Conductivity	Vector Impedance meter (HP 4800) Frequency Count (HP 5300)	Frequency:1 KHz
Complex Impedance	LF Impedance Analyzer (4192A)	Temperature:400°C Frequency:5~5 MHz
X. R. D.	Rigaku (D/MAX-IIA)	Target :Cu Filter :Ni Voltage:30 kV Current:20 mA

ビカス硬度(H_v)와 破壊韌性値(k_{ic})를 구하기 위해 試片의 表面을 잘 연마한 후, ビカス 破度는 micro-vickers hardness tester로 100g의 荷重을 15초 동안 가해서 测定하였다. 破壊韌性値는 vickers hardness tester로 10kg의 荷重을 30초동안 加했을 때 발생한 crack의 길이와 Marshall-Evans^(10,11) 식으로 부터 구하였다.

$$K_{ic} (\text{MPam}^{0.5}) = 0.36E^{0.4}P^{0.6} a^{0.7} (C/a)^{-1.5}$$

P : applied load (N)

E : young's modulus (Pa)

a, c : crack length (m)

5) 電氣傳導度

電氣傳導度를 测定하기 위한 試片의 電極 모양과 测定裝置는 그림 2에 나타내었다.

電氣傳導度는 2단자법으로 450°C~950°C 溫度範圍에서 50°C 간격으로 vector impedance meter를 이용하여 测定하였으며, 電氣傳導度는 다음 식으로 구하였다.

$$\text{電氣傳導度}(\sigma) = L / RA$$

여기서 L은 試片의 두께이고 A는 電極의 斷面積을 나타내며 R은 試片의 저항이다. 이 때 测定周波數은 1KHz였다.

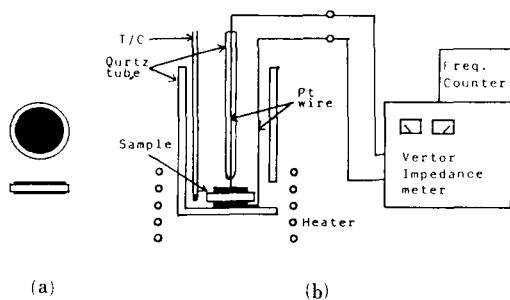


그림 2. (a) 시편의 전극
(b) 전기전도도 측정장치

Fig. 2. (a) Specimen electrode,
(b) Apparatus for measuring electrical conductivity.

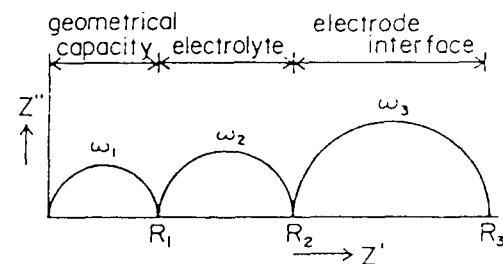
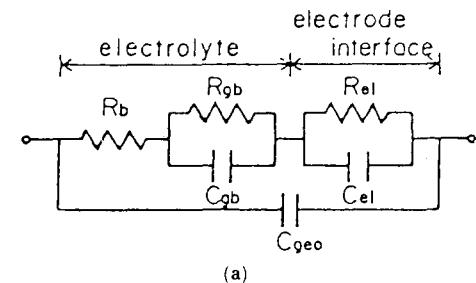


그림 3. (a) 소결체의 등가회로

(b) 주파수에 따른 임피던스 특성 (여기서,
R: 저항, C: 커패시터, b: 별크, gb: 입계
el: 전극)

Fig. 3. (a) Total equivalent electrical circuit,
(b) Complex Impedance diagram of this circuit, where, R:resistance, C:capacity,
b:bulk, gb: grain boundary, el:electrode.

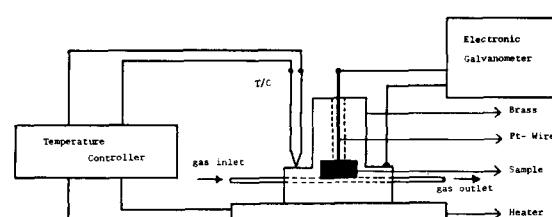


그림 4. (a) 시편의 전극
(b) 전기 전도도 측정장치

Fig. 4. (a) Specimen electrode,
(b) Apparatus for measuring electrical conductivity.

燒結溫度가 높을수록 증가하는 경향을 나타내었다.
그러나 1650°C와 1675°C에서 燒結한 試片의 燒結密度는 거의 변화가 없었다. 따라서 本 實驗에서는 모든 造成의 燒結條件을 1650°C, 4시간으로 固定시켜 燒結하였다.

그림 6은 Al_2O_3 첨가량에 따라 1650°C에서 4시간

III. 結果 및 考察

1. 燒結性

그림 5는 1550°C ~ 1675°C의 溫度範圍에서 燒結한 ZY8試片의 燒結密度를 나타낸 것이다. 燒結密度는

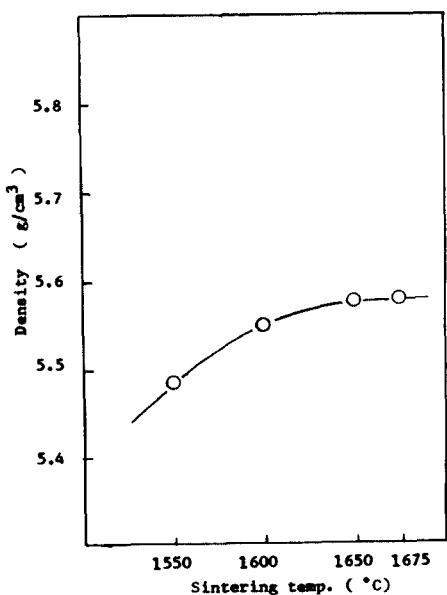


그림 5. 1550°C ~ 1675°C에 소결한 ZY8 시편의 소결밀도

Fig. 5. Sintering density of ZY8 specimen sintered for 4 hrs at 1550 ~ 1675°C.

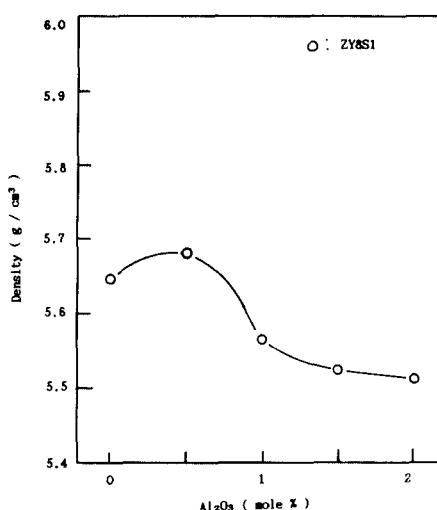


그림 6. Al₂O₃ 첨가량에 따른 소결밀도

Fig. 6. Sintering density vs. Al₂O₃ addition.

燒結한 각試片들의燒結密度를 나타낸 것이다. 燒結密度는 0.5 mole% Al₂O₃가 첨가된 ZY8SA1 試片에서 가장 높게 나타났으며 첨가량이 그이상 증가할수

록 감소하는 경향을 보였다. 또한 燒結密度는 收縮率變化와 유사한 경향을 나타내었다. 즉 收縮率이 증가하면 燒結密度가 증가하고 收縮率이 감소하면 燒結密度가 감소하였다.

그림 7은 ZY8, ZY8S1 그리고 ZY8S1에 Al₂O₃를 0.5 및 2.0 mole% 첨가하여 1650°C에서 4시간 燒結한 각 燒結體들의 X-線回折分析의結果를 나타낸 것이다. ZY8에서는 單斜晶이 존재하였으나 0.5mole% SiO₂가 첨가된 ZY8S1에서는 立方晶相만이 존재하

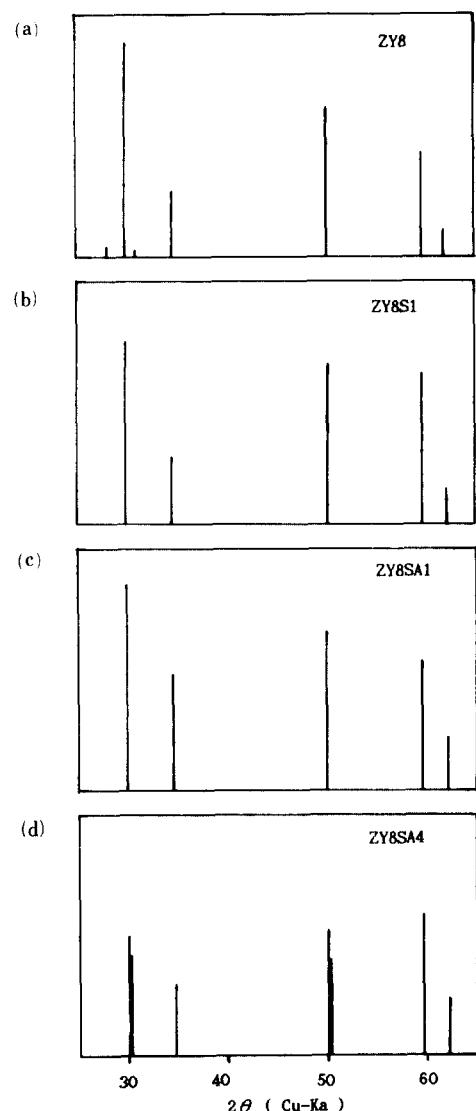


그림 7. 각 소결체들의 X-선 회절분석

Fig. 7. X-ray diffraction pattern of specimens sintered for 4 hrs at 1650°C.

여 完全 安定化가 되었음을 보여주고 있다. 그리고 0.5 mole% Al_2O_3 가 첨가된 ZY8SA1의 경우 더 많은 安定化가 되어 燒結이 촉진되었다. 2.0 mole% Al_2O_3 가 첨가된 ZY8SA4에서는 安定化는 되었으나 30°와 50° 근처에서 doubletet가 존재하였다. 이는 냉각과정에서 cubic 相의 일부가 tetragonal로 相傳移함으로써 나타난 것이라 생각된다.

그림 8은 ZY8S1과 ZY8S1造成에 Al_2O_3 를 0.5, 1.0 및 2.0 mole% 첨가하여 1650°C에서 4시간 燒結한 각 試片들의 表面組織 사진이다. 1.0 mole% Al_2O_3 첨가시 가장 큰 粒子成長이 일어났으며, 그 이상 Al_2O_3 첨가량이 증가함에 따라 粒子의 크기가 감소함을 알 수 있었다. 이것은 ZY8S1 燒結體에 固溶되고 남은 여분의 Al_2O_3 가 粒界에 존재하여 粒子成長을 억제하는 역할을 하기 때문이라 생각된다.

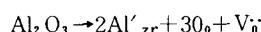
2. 비커스硬度 및 破壊非性

그림 9는 1650°C에서 4시간 燒結한 각 試片에 대하여 SiO_2 와 Al_2O_3 복합 첨가량에 따른 비커스硬度 (Hv)와 破壊非性値 (Kic)를 나타낸 것이다. 비커스硬度는 ZY8S1에서 가장 낮고 0.5 mole% Al_2O_3 가 첨가된 ZY8SA1 燒結體에서 가장 높다가 그 이상 Al_2O_3 가 첨가됨에 따라 감소하는 경향을 나타내었다. 이는 燒結密度가 증가하면 비커스硬度가 증가하고, 燒結密度가 감소하면 비커스硬度가 감소하기 때문이며 Okasaki 등^[14]의 實驗結果와도 유사한 경향을 나타내었다. 그러나 破壊非性値는 Al_2O_3 가 0.5 mole% 이상 첨가됨에 따라 증가하는 경향을 나타내었다.

3. 전기 전도도

그림 10은 1650°C에서 4시간 燒結한 ZY8S1과 ZY8S1에 Al_2O_3 첨가량에 따른 試片의 電氣傳導度를 온도의 逆數로 나타낸 것이다. 電氣傳導度는 Al_2O_3 첨가시 전체적으로 ZY8S1보다 높은 경향을 나타내었다.

Al_2O_3 첨가에 따른 電氣傳導度의 증가는 다음과 같이 설명될 수 있다. Al_2O_3 가 安定化 지르코니아에 첨가될 경우, Al^{3+} 이온이 Zr^{4+} 主格子자리에 置換되어 酸素이온 空格子 (V_o)의 증가로 인하여 電氣傳導度가 증가한다고 생각된다.^[15]



여기서 Al'_{zr} 은 지르코니아 主格子자리에 置換된 Al_2O_3 를 나타낸 것이고 (\cdot) , (\cdot) 은 각과 陽과 陰의 有 效電荷數를 나타낸 것이다. 그림 11은 각 試片의 주 파수 變化에 따른 임피던스 特性을 complex impedance로 나타낸 것이다. 여기서 원쪽 반원은 bulk 자체

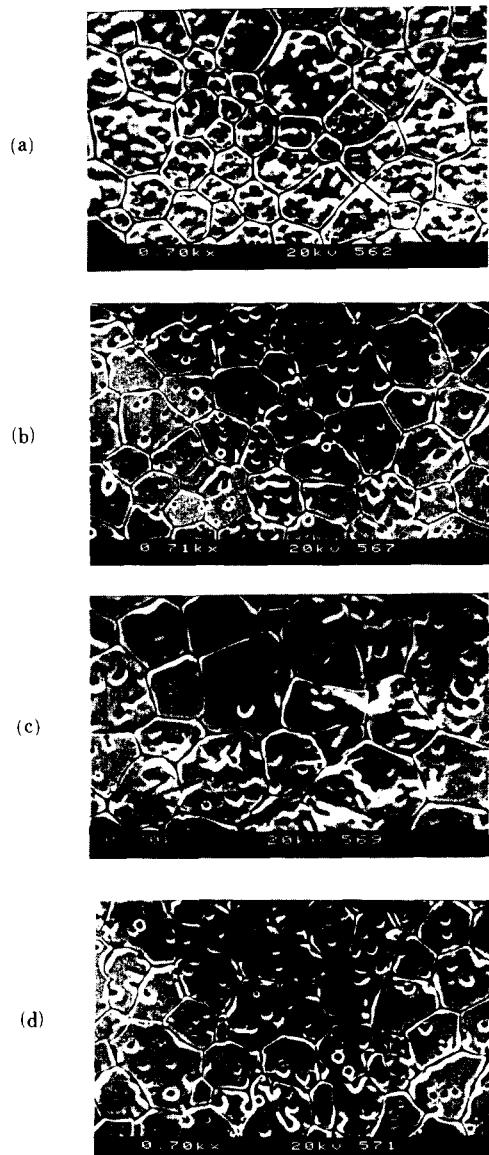


그림 8. Al_2O_3 첨가량에 따른 표면조직 사진

- | | |
|------------|------------|
| (a) ZY8S1 | (b) ZY8SA1 |
| (c) ZY8SA2 | (d) ZY8SA4 |

Fig. 8. SEM photographs of specimens sintered at 1650°C for 4 hrs with Al_2O_3 content.

- | |
|------------------------|
| (a) 0 mole% (ZY8S1) |
| (b) 0.5 mole% (ZY8SA1) |
| (c) 1.0 molu% (ZY8SA2) |
| (d) 2.0 mole% (ZY8SA4) |

의 저항, 중심부 반원은 粒界間 저항을 나타내고 있다.

Al_2O_3 가 0.5 mole% 첨가된 ZY8SA1의 경우 Al_2O_3 ,

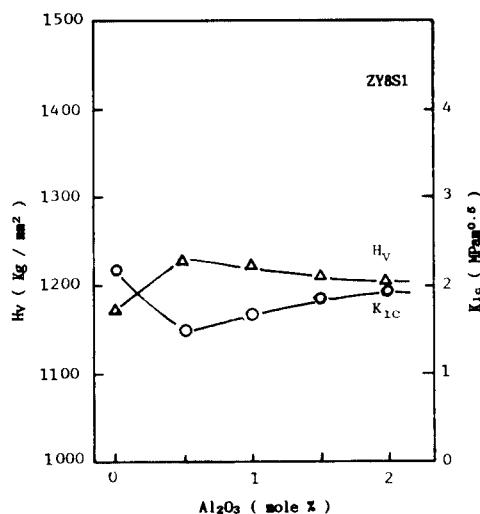


그림 9. Al₂O₃ 첨가량에 따른 각 소결체들의 비커스경도와 파괴인성

Fig. 9. Change of Hv and K_{1c} of specimens with Al₂O₃ addition.

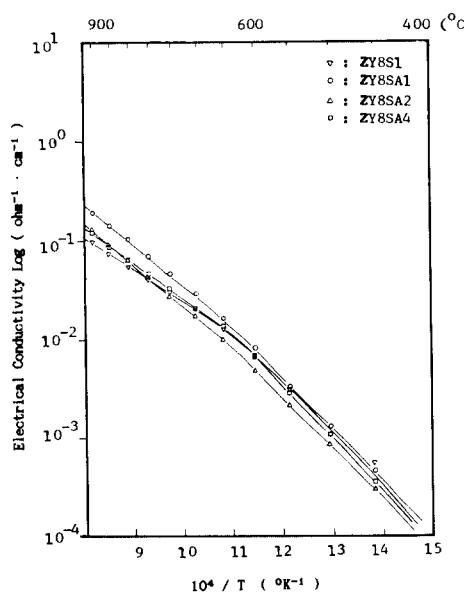


그림10. Al₂O₃ 첨가에 따른 전기전도도

Fig. 10. Arrhenius plots for specimens with Al₂O₃ addition.

가 첨가되지 않은 ZY8S1보다 粒子와 粒界저항이 감소함을 볼 수 있는데 이는 電氣傳導度 特性에서 ZY8S1보다 ZY8SA1의 電氣傳導度가 증가된 것과 잘

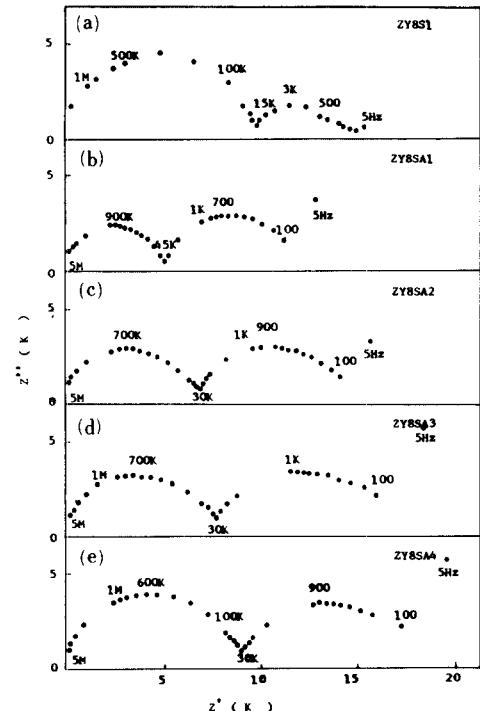


그림11. 주파수 특성에 따른 복소 임피던스

Fig. 11. Complex impedance graphs at 400°C for
 (a) ZY8S1 (b) ZY8SA1
 (c) ZY8SA2 (d) ZY8SA3
 (e) ZY8SA4

일치하고 있다. 그런데 0.5 mole% 이상의 Al₂O₃ 가 첨가됨에 따라 ZY8SA1 보다 粒子 및 粒界저항이 증가하고 있는데 이는 Al³⁺ 이온이 Zr⁴⁺ 이온과 置換하면서 生成된 酸素이온 空格子와 ZY8S1 電解質의 酸素이온 空格子와의 interaction 또는 clustering 문제, 그리고 일부 置換되고 남은 Al³⁺이온이 粒界부근으로擴散되어 粒界에 존재함으로서 粒界間 絶緣層을 형성하게 되어 粒界저항이 증가된 것이라 생각된다.^[7]

4. 酸素分壓 特性

그림12는 酸素分壓에 따른 起電力を 测定한 것이다. SiO₂와 Al₂O₃가 각각 0.5 mole% 복합첨가된 ZY8SA1 試片의 起電力이 153.26 mV로 가장 높았는데 이는 電氣傳導度 및 complex impedance 特性結果와 잘 일치함을 보여주고 있다.

5. 热衝擊 特性

그림13은 각 試片들에 대한 热衝擊 特性을 비커스硬度(Hv)로 나타낸 것이다. 400°C - 900°C 까지 온도

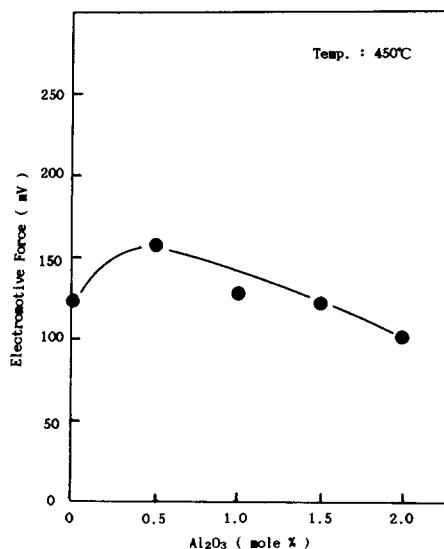


그림12. Al_2O_3 첨가에 따른 기전력(측정온도 450°C)
Fig. 12. Electromotive force vs. Al_2O_3 content at operating temp. of 450°C.

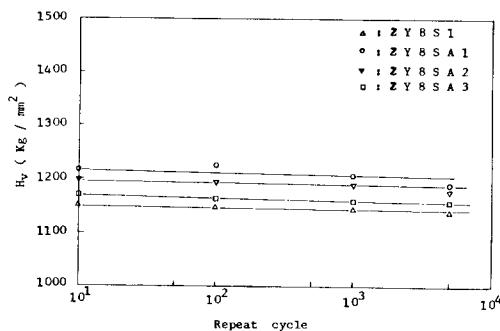


그림13. 열충격 횟수에 따른 비커스경도
Fig. 13. Hv vs. repeat cycles for thermal shocking effect (400°C ~ 900°C).

를 변화시키면서 热衝擊 周期를 1分으로 하여 repeat cycle의 횟수에 따른 비커스硬度를 측정하였으나 長時間의 热衝擊에도 비커스硬度에는 거의 변화가 없었다. 따라서 이 烧結體들은 상당한 耐久性 및 耐熱性을 갖고 있다는 것을 알 수 있다.

IV. 結論

8 mole% Y_2O_3 첨가된 安定化 지르코니아(92 mole%)에 SiO_2 0.5 mole%를 固定시키고 Al_2O_3 를 0

-2.0 mole% 첨가하여 1650°C에서 4시간 동안 空氣中에서 烧結한 烧結體들의 烧結性, 微細構造, 機械的 및 電氣的 特性을 調査, 分析한 結果를 要約하면 다음과 같다.

가) ZY8S1 造成에 Al_2O_3 가 0.5 mole% 첨가된 ZY8SA1 烧結體의 烧結密度가 가장 높게 나타났으며, 1.0 mole% 이상 Al_2O_3 가 添加됨에 따라 烧結密度는 감소하는 경향을 나타내었다.

나) 電氣傳導度와 Complex Impedance 結果에서는 0.5 mole% Al_2O_3 가 첨가되었을 때 가장 높은 傳導性을 나타내었다.

다) 酸素分壓 特性에서도 0.5 mole% Al_2O_3 가 添加되었을 때 起電力이 153.26 mV로 가장 높게 나타났다.

라) 热衝擊 特性은 각 造成에 대하여 repeat cycle 을 5×10^3 回까지 변화시켜도 비커스硬度에는 거의 변화가 없었다.

参考文献

- [1] E.C. Subbarao: Advances in Ceramic, vol. 3, Science and Technology of Zirconia, pp. 1-24, Ed. A.H. Heuer and L.W. Hobbs, The American Ceramic Society, Columbus, Ohio (1981)
- [2] F. Hund, Fluorite phase in the system ZrO_2 - CaO ; Its Defect Structure and Electrical Conductivity, J. Phys. Chem., 189 (1-3), 142-51, 1952.
- [3] 김상희, 최시영, 조상희: 이트리아 안정화 지르코니아 소결체의 특성에 SiO_2 첨가가 미치는 영향, 요업학회지 25(6):601-608, 1988.
- [4] K. Kiukkola and C. Wagner: Measurement on Galvanic Cells involving Solid Electrolytes, J. Electrochem. Soc., 104(6), 393-98, 1959.
- [5] R.C. Garvie, R.H. J. Hannink and R.T. Pascoe: Nature (London), 258(5537), pp. 703-704 (1975)
- [6] J.F. Shackelford and P.S. Nicholson: Influence of SiO_2 on Sintered of Partially Stabilized Zirconia, Ceramic Bulletin, vol. 53, no. 12, 865-867, 1974.
- [7] Masaru Miyayama and Hiroaki Yanagina: Effect of Al_2O_3 Addition on Resistivity and Microstructure of YttriaStabilized Zirconia, Ceramic Bulletin, vol. 65, no. 4, 1986.
- [8] R.L. Coble: J. Appl. Phys., 32, pp. 793 (1961)

- 岡崎清：セラミク誘電體工學，增補版，學獻社，東京，526, 1978.
- [11] A.G. Marshal and A.G. Evans: Reply to Comments on Elastic /Plastic Indentation Damage in Ceramics: The Median G Radial Crack System, J. Am. Ceram. Soc., 64:C, 182-183, 1981.
- [12] M.J. Verkert, B.J. Middelhuis and A.J. Burggraaf: Effect of Grain Boundaries on the Conductivity of High-Purity ZrO₂ YO Ceramics, Solid State Ionics, 6, 159-70, 1981.
- [13] J.E. Bauerle: Study of Solid Electrolyte Polarization by a Complex Admittance Method, J. Phys. Chem. Solids, 30, 2657-70, 1969.
- [14] 齊藤安俊：ジルユニアセラミックス1, pp. 109-125, 内田老鶴園(1983)
- [15] D.W. Strickler and W.G. Carlson: J. Am. Ceram. Soc., 48, pp. 286 (1965)

著者紹介

孫 正 德(準會員)

1964年 4月 25日生. 1987年 경북 대학교 전자공학과 졸업. 1988年 경북대 대학원 전자공학과 입학. 주관 심분야는 세라믹형 산소센서 및 전자세라믹 소자 등임.

●

崔 時 永 (正會員) 第26卷 第11號 參照

현재 경북대학교 전자공학과
부교수

趙 相 熙(正會員)

1941年 8月 21日生. 1965年 한양 대학교 화학공학과 학사. 1975年 경응의숙대학(日本) 응용화학 석사. 1978年 경응의숙대학 응용화학 박사. 1978年～1986年 경북대 전자공학과 조교수, 부교수. 1986年～1989년 경북대 재료공학과 교수. 1990年～현재 경북대 무기 재료공학과 교수.